

PICOSUN™ R-200 ADVANCED

PICOSUN™ R-200 Advanced ALDシステムは、ICコンポーネント、MEMSデバイス、ディスプレイ、LED、レーザーといったエレクトロニクス関連、及びレンズ、光学系、宝石、コイン、医療用インプラント等の3D形状物など、多数のアプリケーションのR&Dに適しています。



技術的特長

PICOSUN™ R-200 Advanced ALDシステムは、何百もの設置実績のある、高度なR&D用ALD装置リサーチツールのグローバルマーケットリーダーです。これは、イノベーションを目指す企業や研究機関に最適なツールです。

アジャイルな設計により、最高品質のALD成膜と、将来的なニーズやアプリケーションにも適合できる非常に柔軟性の高いシステムが可能になっています。それぞれ完全に分離されたプリカーサ注入口及び計装器類を備えた特許取得済みのホットウォール設計によりパーティクルフリーの処理が可能になり、ウエハ、3D形状物、及びナノスケール形状の幅広い材料に適用できます。当社独自の Picoflow™テクノロジーにより、多孔質、超高アスペクト比、ナノ粒子など非常に困難なサンプル上においても優れた均一性が実現できます。PICOSUN™ R-200 Advanced システムには、液体、気体、および固体原料用の高機能で交換が容易なプリカーサソースが装備されています。高効率で特許取得済みのリモートプラズマオプションにより、ショートやプラズマ損傷のリスクなしに金属の成膜もできます。グローブボックス、UHVシステム、手動および自動ローダー、クラスターツール、粉体成膜ユニット、および種々のin-situ分析システムとの統合により、現在の、また将来の研究分野が何であれ、効率的で柔軟な研究が可能になり、優れた結果を得ることができます。

標準的な基板サイズと種類

- 50-200 mm 枚葉ウエハ
- 156 mm x 156 mm ソーラー Si ウエハ
- 3D形状物
- 粉末および微粒子
- ミニ バッチ
- 多孔質、貫通孔、高アスペクト比 (1:2500~)

処理温度

- 50~500°C、プラズマの場合450°C
(ご要望に応じ加熱チャックにて650°Cまで可能)

標準プロセス

- Al_2O_3 、 TiO_2 、 SiO_2 、 Ta_2O_5 、 HfO_2 、 ZnO 、 ZrO_2 、 TiN 、 AlN 、 Pt や Ir などのメタル

基板ローディング

- 空気圧リフトによるマニュアルローディング
- マグネティックマニピュレータームによるロードロック
- ハンドリングロボットによるセミオートローディング
- クラスターツールによるカセット to カセットのローディング

プリカーサ

- 液体、固体、気体、オゾン
- 6カ所に分かれた注入口 (プラズマオプションがあれば7カ所) から最大12種のソース

オプション

- クラスターツール、Picoflow™ ディフュージョンエンハンサ、RGA、UHV対応、 N_2 ジェネレータ、除害装置、カスタマイズデザイン、不活性環境ローディング対応グローブボックス

最高品質のALDシステムを、
要求の厳しいアプリケーションへ

詳細な情報をご希望の方は、お気軽にご相談ください。

picosun
AGILE ALD